高频放大晶体管

描述：

硅外延 NPN 晶体管

高频，f_T 典型值 4GHz

低噪声

应用：

高频放大，工作频率 900 MHz

应用条件 (T=25℃)

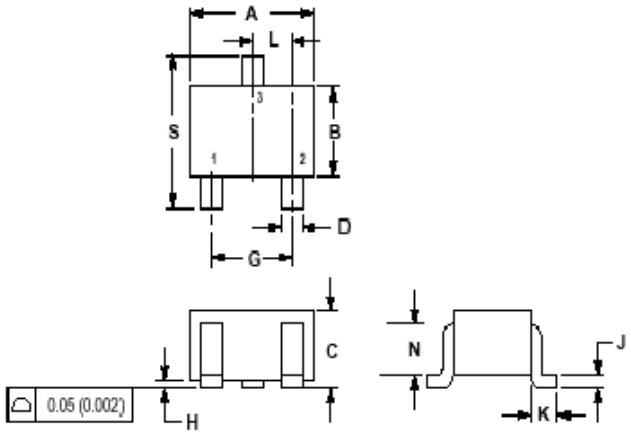
参数	符号	最大值	单位
BC 结击穿电压	V_{CBO}	20	V
EC 结击穿电压	V_{CEO}	12	V
EB 结击穿电压	V_{EBO}	3	V
集电极电流	I_C	50	mA
功耗	P_C	0.2	W
结温	Tj	150	℃
保存温度	Tstg	-55-+150	℃

电学特性 (T=25℃)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
BC 结击穿电压	BV_{CBO}	20			V	IC=10μA
EC 击穿电压	BV_{CEO}	12			V	IC=1mA
EB 结击穿电压	BV_{EBO}	3			V	IE=10μA
BC 结漏电流	I_{CBO}			0.5	μA	Vcb=10V
EB 结漏电流	I_{EBO}			0.5	μA	Veb=2V
CE 饱和电压	VCE (SAT)			0.5	V	Ic/Ib = 10m A / 5m A
电流增益	hFE	56	70	180		VCE/IC=5V/5mA
频率	f_T	1.4	4		GHz	VCE=10V, IC=10mA
输出电容	Cob		0.8	1.5	pF	Vcb=10V,Ie=0A, f= 1MHz
噪声因子	NF		3.5		db	Vce=8V, Ic=2m A, f=500MHz Rg=50Ω

封装尺寸

SOT323/SC70

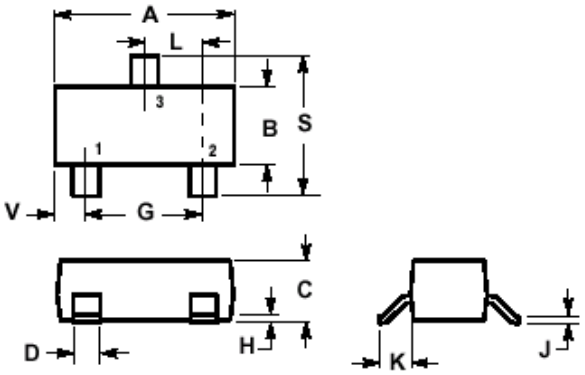


NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.071	0.087	1.80	2.20
B	0.045	0.053	1.15	1.35
C	0.032	0.040	0.80	1.00
D	0.012	0.016	0.30	0.40
G	0.047	0.055	1.20	1.40
H	0.000	0.004	0.00	0.10
J	0.004	0.010	0.10	0.25
K	0.017 REF		0.425 REF	
L	0.026 BSC		0.650 BSC	
N	0.028 REF		0.700 REF	
S	0.079	0.095	2.00	2.40

PIN 1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR

SOT23



NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD FINISH THICKNESS. MINIMUM LEAD THICKNESS IS THE MINIMUM THICKNESS OF BASE MATERIAL.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.1102	0.1197	2.80	3.04
B	0.0472	0.0551	1.20	1.40
C	0.0350	0.0440	0.89	1.11
D	0.0150	0.0200	0.37	0.50
G	0.0701	0.0807	1.78	2.04
H	0.0005	0.0040	0.013	0.100
J	0.0034	0.0070	0.085	0.177
K	0.0140	0.0285	0.35	0.69
L	0.0350	0.0401	0.89	1.02
S	0.0830	0.1039	2.10	2.64
V	0.0177	0.0236	0.45	0.60

STYLE 8:
PIN 1. ANODE
2. NO CONNECTION
3. CATHODE